$Ag 和 Ti 底层对 Fe/Pt]_ 多层膜有序化的影响*$

冯 春¹) 李宝河¹⁾²⁾ 滕 蛟¹) 杨 涛¹) 于广华¹

¹(北京科技大学材料物理系,北京 100083) ²(北京工商大学数理部,北京 100037) (2005年1月14日收到2005年3月1日收到修改稿)

利用磁控溅射的方法,在热玻璃基片上制备了以 Ag, Ti, Cu, Cr, Pt 和 Ta 为底层的[Fe/Pt], 多层膜,后经不同温 度真空热处理,得到 Ll₀ 有序结构的 FePt 薄膜(Ll₀-FePt).实验结果表明,以 Ag 和 Ti 为底层,通过采用基片加温,同 时利用[Fe/Pt], 多层膜结构,可以促进 FePt 薄膜的有序化过程,使 FePt-Ll₀ 有序化温度从 500℃降低到 350℃.在较 高的温度下退火,以 Ag 为底层对薄膜的磁性能影响较小,而以 Ti 为底层在高于 500℃退火后,矫顽力明显下降.在 400℃退火 20min 后,以 Ag 和 Ti 为底层的样品平行膜面的矫顽力分别达到 597kA/m 和 645kA/m,剩磁比分别达到 0.81 和 0.94,为将来 FePt-Ll₀ 有序相合金薄膜用于未来超高密度磁记录介质打下基础.

关键词:L1₀-FePt 薄膜,有序化温度,底层,多层膜结构 PACC:7550S,7570F

1.引 言

近 10 年来磁硬盘技术得到了飞速发展,目前实 验室的硬盘磁记录面密度已达到 23.23Gb/cm¹⁻³¹, 超高密度磁记录的下一个目标是突破 156Gb/cm².要 实现这么高的面密度,记录介质中的磁性微粒尺寸 必须降低到 5nm 以下,且大小分布均匀.当磁性颗 粒如此小的情况下,超顺磁效应使得热稳定性成为 一个突出的问题,因此必须提高记录介质材料的磁 各向异性以提高其热稳定性.L1₀-FePt 合金具有高 达 7 × 10⁶ J/m³ 的单轴磁晶各向异性能⁴¹,同时它还 具有矫顽力高、磁能级高和抗腐蚀能力强的特点,能 够满足超高密度磁记录对热稳定性的需要,成为下 一代磁记录介质的首选材料.

直接溅射得到的 FePt 合金为无序的面心立方 结构(fcc),是一种软磁相,必须通过较高温度(高于 500℃)^{5 6]}的退火才能形成有序四方结构(fct)的硬 磁相.过高温度退火不利于形成较小的 FePt 颗粒以 提高磁记录密度,而且对于工业生产也是极为不利 的.因此降低 FePt-L1₀ 薄膜的有序化温度和改善其 微结构及磁性能是急待解决的问题.目前国际上降 低有序化温度的方法主要有利用多层膜结构或分子 束外延(MBE $\int^{7.81}$ 、掺加第三种元素(如 Cu,Zr 等 $\int^{9.01}$ 、利用不同的底层(如 Ag,Au,CrRu 等 \int^{10-131} .其中Xu等人研究发现以Ag做底层可以 降低 FePt 单层膜的有序化温度^{[131},但其退火时间过 长、FePt 层较厚(100nm),不利于实现 FePt 颗粒的细 化.Chen等人研究发现以Ti为底层可以细化FePt 颗粒^{[141},但为达到良好的磁性能,基片温度过高 (600°C)以及FePt 层较厚(300nm),不利于工业生产 和FePt 颗粒的细化.我们已经报道利用[Fe/Pt],多 层膜可以大幅度降低FePt薄膜有序化的温度¹⁵¹,为 了更大幅度的降低FePt薄膜有序化的温度和改善 FePt薄膜的微结构和表面性质,本文研究了不同底 层对[Fe/Pt],多层膜有序化和磁性能的影响.

2. 实 验

所有薄膜样品均利用 DV-502 型磁控溅射仪制 备,其本底真空度优于 5×10⁻⁵Pa.在玻璃基片上,利 用高纯 Ag 靶(99.99%),Ti 靶(99.99%),Ta 靶 (99.99%),Cu 靶(99.99%),Cr 靶(99.99%)射频溅 射底层,然后用高纯的 Fe 靶(99.99%)Pt 靶

^{*}教育部博士点基金(批准号 2003008003)和教育部科学技术研究重要项目(批准号 :104023)资助的课题.

[†]通讯联系人.E-mail:ghyu@mater.ustb.edu.cn

(99.99%) 直流交替溅射[Fe/Pt]₃多层膜.基片温度 控制在 250℃, Ar 气压恒定在 0.45Pa, 所有底层的厚 度控制在 50nm [Fe/Pt]₃多层膜中每层 Fe 和 Pt 的 厚度控制在 1.5nm.直接溅射的薄膜在真空度优于 6 ×10⁻⁵Pa 的真空退火炉中进行退火处理, 退火温度 选择 350—550℃之间, 退火时间控制在 20min.

利用 x 射线衍射(XRD)分析样品的结构(Cu-Kα).利用 MicroMag2900 型梯度磁强计(AGM)测量 样品的磁性 ,测量中施加的磁场方向平行于膜面 ,最 大的磁场强度为 1432kA/m.薄膜沉积速率由台阶仪 测厚度来确定.

3. 结果与讨论

图 1 给出了以 Ag 为底层的[Fe/Pt]₃多层膜经 350℃ 400℃ 500℃ 550℃退火 20min 后的 XRD 图. 为定量描述 FePt 有序化程度,引用有序度参数 S, 其定义为^[16]

$$S^{2} = \frac{1 - (c/a)}{1 - (c/a)_{s}}.$$
 (1)

 $(c/a)_s$ 为完全有序的 fet 结构的的晶格参数之

比,可以从文献 16 查到 (c/a)由各 XRD 图求得. 如图 1 所示,以 Ag 为底层时,所有的 XRD 谱均出现 了 Ag 111)和 Ag 200)峰,由于 FePt 沿 Ag 晶粒外延 生长,退火后出现了较强的 FePt(111)和 FePt(200) 峰 经 350℃热处理,出现了 FePt(001)超晶格衍射 峰,随着退火温度的升高,FePt(001)超晶格衍射 峰,随着退火温度的升高,FePt(001)峰的相对强度 逐渐升高;当退火温度达到 500℃时出现了 FePt (200)和 FePt(002)峰的分开,表明晶格参数 a 和 c发生变化.退火温度进一步升高到 550℃时,两峰分 开的就更加明显了,表明 c/a 的值进一步降低.利 用公式(1)计算 S,表明随着退火温度的提高,样品 的有序度参数由 0.6 变化到 0.88,说明随退火温度 的升高,FePt 合金的有序度逐渐升高,同时这些结果 也表明以 Ag 为底层和[Fe/Pt]₃ 多层膜可以促进 FePt 薄膜的有序化.

图 2 显示了以 Ti 为底层时 [Fe/Pt]₃多层膜经 不同温度退火 20min 后的 XRD 图.经 350℃退火后 XRD 谱出现了 FePt(001)超晶格峰,表明 Ti 为底层 和 Fe/Pt]₃多层膜结构同样促进了 FePt 的有序化过 程;当退火温度达到 400℃时,FePt(200)和 FePt(002) 峰有分开的迹象,但当退火温度达到 550℃时,FePt (200)和 FePt(002)峰又合并成一个峰,表明出现了



图 1 Ag/[Fe/Pt]3多层膜在不同退火温度 20min 退火后的 XRD 图

结构的转变,可能在高温热处理时,底层 Ti 原子沿 FePt 晶内扩散¹⁷¹,影响了 FePt-L1₀ 有序相结构.这 一现象与 Ag 为底层时的情况并不相同,由于 Ag 在 FePt 中的固溶度较小,高温退火时虽然会有 Ag 扩散 到 FePt 薄膜中,形成 L1₀-FePt 和 Ag 的复合双相,不 会形成合金,对 FePt 的有序结构没有影响.



图 2 Tif Fe/Pt] 3多层膜在不同退火温度 20min 退火后的 XRD 图

图 3 是 Ag[Fe/Pt]₃ 经不同退火温度(350℃, 400℃ 500℃ 550℃)退火 20min 后的磁滞回线,所加 外场方向平行于膜面.横坐标为外加磁场(H),纵坐 标为磁化强度 M 与饱和磁化强度 M_s 之比.由图示 出,以 Ag 为底层在退火温度为 350℃时,平行膜面 方向的磁滞回线出现了峰腰,并且矫顽力和剩磁比 M_r/M_s 均较低,原因是由于在 350℃下退火 20min, 薄膜已经有部分发生无序-有序的转变,此时同时存



图 3 Ag/[Fe/Pt]3在不同退火温度 20min 退火后的磁滞回线

在软磁相和硬磁相,磁滞回线出现了峰腰.随着退火 温度的升高,有序度逐渐增高,越来越多的软磁相转 化成硬磁相,矫顽力和剩磁比逐渐增大,这一点与图 1中的结论一致.退火温度达到400℃时,矫顽力已 达到597kA/m,剩磁比为0.81;当退火温度为550℃ 时,矫顽力达到极值955kA/m,剩磁比为0.94,矫顽 力值比 Xu等^[13]报告的结果(750kA/m)有明显改善.

图 4 是 Ti/[Fe/Pt]₃ 经不同退火温度(350℃, 400℃,500℃,550℃) 退火 20min 后的磁滞回线.由图 示出,以 Ti 为底层,在退火温度为 350℃时,矫顽力 达到 318kA/m,与 Ag 为底层不同,磁滞回线没有出 现明显的峰腰.随着退火温度的升高,在相同的时间 内有更多部分的软磁相转化为硬磁相,矫顽力和剩 磁比逐渐增大,退火温度达到 400℃时,矫顽力已达 到 645kA/m 剩磁比为 0.94;在 500℃退火 20min 后 矫顽力达到 700kA/m,剩磁比为 0.94.但当退火温度 高于 500℃,由于 Ti 扩散到 FePt 晶格中与 FePt 形成 合金,破坏了 L1₀-FePt 有序结构,使得矫顽力和剩磁 比下降,这一点与图 2 中的结论一致.

为了进一步了解其他底层对 Fe/Pt 多层膜有序 化和磁性的影响,我们在相同的溅射条件下制备了 Cr .Cu ,Pt 和 Ta 为底层的[Fe/Pt]₃多层膜,然后均经 350 °C ,400 °C ,500 °C ,550 °C 四个不同温度真空退火 20min.图 5 给出了不同底层样品的矫顽力 H_c 随热 处理温度 T_A 的变化关系.实验表明,以 Cu 为底层 的样品矫顽力较低(小于 80kA/m),未形成有序化较 好的 FePt 薄膜;以 Pt 为底层的样品矫顽力在高于 400 °C 热处理时就开始大幅度下降,说明 FePt 薄膜 的有序化降低;以 Ta ,Cr 为底层的样品矫顽力不高,



图 4 Tif Fe/Pt]3在不同退火温度 20min 退火后的磁滞回线

且随退火温度的变化不大.比较来看,在400℃热处 理时,以Ti为底层的样品可获得最大的矫顽力,而 在550℃热处理时,以Ag为底层可获得最大的矫顽 力,其他不同底层的样品磁性能较低或在较低的温 度下就出现了矫顽力的下降,具体原因以及底层对 表面形貌和微结构的影响我们还正在进行深入的 研究.



图 5 不同底层样品的矫顽力 H_c 随热处理温度的变化关系

4.结 论

实验结果表明以 Ag 和 Ti 为底层 利用[Fe/Pt], 多层膜结构,均可以促进 FePt 薄膜有序化过程,使 FePt 薄膜的有序化温度至少降低了 150℃.但 Ag 和 Ti 为底层对多层膜热处理后的磁性和结构的影响 不同.在低于 400℃退火后,以 Ag 为底层的样品磁 滞回线出现峰腰,而 Ti 为底层没有出现这种现象; 在高于 500℃退火后,以 Ti 为底层的样品矫顽力下 降,而以Ag为底层的样品随着退火温度的升高,矫 顽力一直增大,L1₀有序度也增加.

在 400℃退火 20min 后,以 Ag 为底层的样品平 行膜面的矫顽力已达到 597kA/m,剩磁比为 0.81,而 以 Ti 为底层的样品矫顽力已达到 645kA/m, 剩磁比 为 0.94 均实现了较低温度的有序化,为将来 FePt-L1。有序相合金薄膜用于未来超高密度磁记录介质 打下基础.

- [1] Mao S , Linville E , Nowak J et al 2004 IEEE Tran . Magn . 40 307
- [2] Huang F, Li B H, Yang T et al 2005 Acta Phys. Sin. 54 1841 (in Chinese)[黄 阀、李宝河、杨 涛等 2005 物理学报 54 1841]
- [3] Li B H, Huang F, Yang T et al 2005 Acta Metal. Sin. 54 659 (in Chinese) [李宝河、黄 阀、杨 涛等 2005 金属学报 54 659]
- [4] Weller D 2000 IEEE Tran. Magn. 36 10
- [5] Kuo C M , Kuo P C and Wu H C 1999 J. App. Phys. 85 2264
- [6] Wang Y Z, Zhang M C, Qiao Y et al 2000 Acta Phys. Sin. 49
 1600 (in Chinese)[王亦忠、张茂才、乔 等 2000 物理学报
 49 1600]
- [7] Endo Y , Kikuchi N , Kitakami O et al 2001 J. App. Phys. 89 7065
- [8] Farrow R F C , Weller D , Marks R F et al 1998 J. App. Phys. 84 934
- [9] Takahashi Y K, Ohuma M and Hono K 2002 J. Magn. Magn. Mater. 246 259

- [10] Lee S R, Yang S and Keunkim Y 2001 Appl. Phys. Lett. 78 4001
- [11] Seki T , Shima T and Takanashi K 2004 J. Magn. Magn. Mater. 272-276 2182
- [12] Xu Y F , Chen J S and Wang J P 2002 Appl . Phys . Lett . 80 3325
- [13] Xu X H , Wu H S , Wang F et al 2004 Applied Surface Science . 233
- [14] Chen S C , Kuo P C , Kuo S T et al 2003 Materials Science and Engineering. B 98 244
- [15] Li B H, Huang F, Yang T et al 2005 Acta Phys. Sin. 54 1836(in Chinese)[李宝河、黄 阀、杨 涛等 2005 物理学报 54 1836]
- [16] Endo Y, Kikuchi N, Kitakami O et al 2001 J. Appl. Phys. 89 (11) 7065
- [17] Cai C L, Teng J, Yu G H et al 2002 Acta Phys. Sin 51 1846 in Chinese)[柴春林、滕 蛟、于广华等 2002 物理学报 51 1846]

Effect of Ag and Ti underlayer on the ordering in Fe/Pt multilayers *

Feng Chun¹) Li Bao-He¹⁾²) Teng Jiao¹) Yang Tao¹) Yu Guang-Hua¹)[†]

1) (Department of Material Physics and Chemistry , Beijing University of Science and Technology , Beijing 100083 , China)

² (Department of Mathmatics and Physics , Beijing Technology and Business University ,Beijing 100037 , China)

(Received 14 January 2005; revised manuscript received 1 March 2005)

Abstract

The Fe/Pt multilayers with Ag ,Ti ,Cu ,Cr ,Pt and Ta underlayers were prepared by DC magnetron sputtering on the heated glass substrates. After vacuum annealing at different temperatures , the FePt thin films with Ll_0 ordering phase (Ll_0 -FePt) were obtained. Results showed that the Ag and Ti underlayer prompt the ordering of FePt thin films , and the ordering temperature of FePt-Ll₀ phase is reduced by at least 150 °C. It is also worth noting that the annealing time is shorter and the magnetic performance is excellent. The magnetic performance of samples with Ag underlayer is not sensitive to temperature at relative higher annealing temperature , whereas the coercivity of samples with Ti underlayer decreases obviously when the annealing temperature is higher than 500 °C. After annealing at 400 °C for 20 min , the in-plane coercivity of samples with Ag and Ti underlayer can be as high as 597kA/m , and 654kA/m , respectively , and the ratio of remanent magnetization to saturation magnetization reaches 0.81 and 0.94 , respectively , implying the potential of the films as future magnetic recording media of ultrahigh density.

Keywords : $L1_0$ -FePt thin films , ordering temperature , underlayer , multilayer structure **PACC** : 75508 , 7570F

^{*} Project supported in part by the Doctoral Foundation of the Ministry of Education (Grant No. 2003008003) and the Major Program of the Science and Technology Foundation of the Ministry of Education (Grant No. 104023).

[†]Corresponding author. E-mail : ghyu@mater_ustb.edu.cn